

複合素子

品名 Type No.	用途 Use
μ PA15A	差動増幅器 (NPN Dual Transistor)
μ PA33A	チョッパ、差動増幅器、インピーダンス変換 (P-ch Dual MOS FET)
μ PA34A	チョッパ、差動増幅器 (N-ch Dual MOS FET)
μ PA36A	チョッパ (NPN Dual Transistor)
μ PA37A	微小電圧増幅 (")
μ PA38A	低レベル差動増幅 (")
μ PA39A	低レベル差動増幅 (")
μ PA44D	高速度スイッチング (Diode Array 16)
μ PA46D	大電流高速度スイッチング (NPN Quad Transistor)
μ PA47D	大電流高速度スイッチング (")
μ PA48D	大電流高速度スイッチング (")
μ PA49A	低レベル差動増幅 (PNP Dual Transistor)
μ PA53C	高利得増幅(トランジスタアレイ) (Darlington Transistor Array)
μ PA54H	高速度スイッチング(ダイオードアレイ) (Diode Array 6)
μ PA56C	セグメントドライバ(トランジスタアレイ) (Transistor Array 7)
μ PA57C	高利得増幅(トランジスタアレイ) (Darlington Transistor Array)
μ PA60A	差動増幅 (N-ch Dual Junction FET)
μ PA61A	差動増幅 (")
μ PA62C	差動増幅バランス MIX (")
μ PA63H	差動増幅 (")
μ PA64H	高速度スイッチング(ダイオードアレイ) (Diode Array 6)
μ PA67C	高利得増幅(トランジスタアレイ) (Darlington Transistor Array)
μ PA70A	差動増幅 (N-ch Dual Junction FET)
μ PA71A	差動増幅 (")
2SC294	差動増幅 (NPN Dual Transistor)
2SC603	双方向スイッチング (")
2SC1265	差動増幅、超高速度スイッチング (")
2SC1657	差動増幅、超高速度スイッチング (")
2SC1658	差動増幅、超高速度スイッチング (")
2SC1661	差動増幅、超高速度スイッチング (")
2SC1662	差動増幅、超高速度スイッチング (")
2SC1731	差動増幅、超高速度スイッチング (")
2SC1732	差動増幅、超高速度スイッチング (")
2SC1733	差動増幅 (")
2SC1924	差動増幅、超高速度スイッチング (")
2SC1925	差動増幅、超高速度スイッチング (")
2SC1926	差動増幅、超高速度スイッチング (")
2SC1927	差動増幅、超高速度スイッチング (")

ここに掲載品種の個別詳細特性規格、特性曲線などにつきましては別途資料をご参照ください。

複合素子

■デュアル トランジスタ/Bipolar Dual Transistor

品名 Type No.	品質 グレード	用途 Use	構造 Structure	外形 Outline	絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)					電 気 的 特 性	
					V _{CE0} (V)	V _{CE0} (V)	V _{BE0} (V)	I _C (mA/unit)	P _C (mW/unit)	T _J (°C)	I _{CEO} (μA) V _{CE} (V) MAX.
2SC294	Q ₂	Diff.	NPN, D, Si	TO-78(A)	25	12	5	50	300	175	10 0.1
2SC603	Q ₂	Chop.	NPN, E, Si	TO-46類似	7	*4.5	7	50	*200	150	6.0 1.0
μPA15A	Q ₃	Diff.	NPN, D, Si	TO-78(A)	25	12	5	50	300	150	10 0.1
μPA36A	Q ₃	Chop.	NPN, E, Si	TO-46類似	7	*5	7	50	*200	150	6.0 0.05
μPA37A	Q ₂	Diff. SW.	NPN, E, Si	TO-78(A)	25	13	5	80	150	175	15 0.1
μPA38A	Q ₃	Diff.	NPN, E, Si	TO-78(B)	60	40	5	50	300	175	15 100 pA
μPA39A	Q ₃	Diff.	NPN, E, Si	TO-78(B)	60	40	5	50	300	175	15 500 pA
μPA49A	Q ₃	Diff.	PNP, E, Si	TO-78(B)	-60	-40	-5	-50	300	175	-30 -0.1

※日本電信電話公社認定品 μPA37A-A, μPA38A-A, μPA49A-A *V_{CEB}

*全損失

■デュアル FET/Dual FET

品名 Type No.	品質 グレード	用途 Use	構造 Structure	外形 Outline	絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)					電 気 的 特 性			
					V _{GS} (V)	V _{DS} (V)	I _D (mA/unit)	P _D (mW/unit)	T _J (°C)	I _{GSS} (pA) V _{GS} (V) MAX.	I _{DSS} (mA) V _{DS} (V) TYP. MAX.		
μPA33A	Q ₂	Chop.	P ch. MOS, Dual	TO-78(C)	±30	-30	-20	100	125	-10 -10			
μPA34A	Q ₂	Chop. Diff.	N ch. MOS, Dual	TO-78(C)	±30	20	10	100	125	10 10	10 0.6 2.5		
μPA60A	Q ₃	Diff.	N ch. J. Dual	TO-78(D)	*-40	*40	*50	250	175	-20 -100	10 2.0 5.0		
μPA61A	Q ₃	Diff.	N ch. J. Dual	TO-78(D)	*-40	*40	*50	250	175	-20 -100	10 2.0 5.0		
μPA62C	一般	Mix.	N ch. J. Dual	DIP(A)	*-20	-	32	350	125	-8 -50 nA	10 16 32		
μPA63H	一般	Diff.	N ch. J. Dual	SIP(A)	*-60	*60	30	250	125	-20 -1.0 nA	10 6.0 20		
μPA70A	Q ₃	Diff.	N ch. J. Dual	TO-71	*-40	*40	*50	250	175	-20 -100	10 2.0 5.0		
μPA71A	Q ₃	Diff.	N ch. J. Dual	TO-71	*-40	*40	*50	250	175	-20 -100	10 2.0 5.0		

*品質グレード Q₂ 高信頼度通信工業用 *V_{GSD} *V_{DSS} *I_C

Q₃ 通信工業用

Q₄ 軽工業用

太字で書かれた品種は主幹製品です。新規設計にはこれらの品種をおすすめします。

■外形図/Package Dimensions (Unit: mm)

TO-78(A)	TO-46 類似	TO-78(B)	TO-78(C, D)
Connection Diagram - Emitter 1 - Base 1 - Collector 1 - Collector 2 - Base 2 - Emitter 2 EIAJ : TC-5A, TB-25C JEDEC : MO-002AG IEC : C4	Connection Diagram - Base 1 - Base 2 - Emitter 1 - Collector (Case) EIAJ : — JEDEC : — IEC : —	Connection Diagram - Emitter 1 - Base 1 - Collector 1 - Sub. Case 1 - Collector 2 - Base 2 - Emitter 2 - Sub. Case 2 EIAJ : TC-5A, TB-26C JEDEC : MO-002AG (TO-78) IEC : C4, B7C	C. Connection Diagram - Source 1 - Drain 1 - Gate 1 - Sub. (Case) - Gate 2 - Drain 2 - Source 2 - NC D. Connection Diagram - Source 1 - Drain 1 - Gate 1 - Sub. (Case) - Source 2 - Drain 2 - Gate 2 - Sub. (Case) EIAJ : TC-5A, TB-26C JEDEC : MO-002AG (TO-78) IEC : C4, B7A (リード長さ 38.1 は異なる)

特に指定のない寸法は標準値を示します。

